

Дифракция электромагнитной волны на планарной структуреК.В. Бухенский¹, А.Б. Дюбуа¹, С.И. Кучерявый², С.Н. Машнина¹, А.С. Сафошкин¹,
А.А. Стрельников¹¹Рязанский государственный радиотехнический университет²Обнинский институт атомной энергетики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ

В работе рассмотрен процесс дифракции ТМ – поляризованной электромагнитной волны гауссова пучка на МДП (металл – диэлектрик – полупроводник) структуре с учетом нелинейности диэлектрической проницаемости полупроводниковой пленки. В рамках теории развит модовый метод расчета процесса взаимодействия излучения со структурой, позволяющий рассчитывать для фиксированного потока энергии возмущения потоки энергий возникающих в процессах дифракции. Процессы перераспределения энергии в результате дифракции электромагнитного излучения в диэлектрических средах представляют собой одну из важнейших задач интегральной оптики. По сравнению с процессами распространения электромагнитного излучения вдоль многослойных структур с параллельными (или коаксиальными) границами раздела, которые хорошо изучены и систематизированы к настоящему времени [1,2,8], дифракционные задачи изучены гораздо слабее. Основная проблема заключается в больших математических сложностях, связанных с решением уравнений Максвелла в средах, где границы раздела между средами суть не параллельные плоскости. Условия непрерывности в совокупности с уравнениями Максвелла для таких задач связаны с решением сложных интегродифференциальных уравнений [3], которые имеют аналитическое решение только для определенных геометрий [4]. В работе произведен расчет процесса отражения гауссова пучка с возбуждением поверхностных и объемных электромагнитных полей в структуре, где уже при относительно небольших напряженностях электромагнитного поля нелинейность в диэлектрической проницаемости будет сказываться на процесс отражения от нелинейной структуры. Последний представляет собой четыре области, характеризующиеся диэлектрическими проницаемостями ϵ_1 - вакуум, $\epsilon_2(\omega)$ - металл, ϵ_3 - тонкая полупроводниковая нелинейная пленка, ϵ_4 - диэлектрик.

Уравнения Максвелла

$$i\omega\mathfrak{H} = c \operatorname{rot} \mathfrak{E} \text{ и } i\omega\epsilon_i(\omega)\mathfrak{E} = -c \operatorname{rot} \mathfrak{H} \quad (1)$$

в декартовой системе в совокупности с гармоническим характером распространения каждой моды вдоль оси X $\{\mathfrak{H}(x, z), \mathfrak{E}(x, z)\} = \{\mathbf{H}(z), \mathbf{E}(z)\} \exp(ik_x x)$ связывают компоненты мод ТМ — поляризованно-

го излучения (E_x, E_z, H_y) следующим образом: $\mathfrak{E}_x(x, z) = \frac{ic}{\omega\epsilon_i} \frac{\partial H_y}{\partial z}$; $\mathfrak{E}_z(x, z) = \frac{ic}{\omega\epsilon_i} \frac{\partial H_y}{\partial x}$; $E_x(z) = \frac{ic}{\omega\epsilon_i} \frac{dH_y}{dz}$;

$E_z(z) = -\frac{c}{\omega\epsilon_i} k_x H_y(z)$, что легко получить из (1), учитывая планарность задачи [8]. Огибающие моды

$H(z)$, а также волновое число k_x определяются из волнового уравнения и граничных условий. Волновое уравнение вытекает из (1) и дает зависимость поля $H_y(z)$ для каждого из квадрантов:

$$\frac{d^2 H_y}{dz^2} + \left[\frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_i - k_x^2 \right] H_y = 0 \quad (2)$$

с граничными условиями $H_y(z = -0) = H_y(z = +0)$, $E_x(z = -0) = E_x(z = +0)$, которые полностью определяют структуру каждой моды при $x < 0$ и $x > 0$. Как нетрудно убедиться, решение уравнения (2) при

$x < 0$ имеет вид: $H_{1y}(z) = B_1 \exp(i\beta z) + B_2 \exp(-i\beta z)$, $E_{1z}(z) = -\frac{ck_x^{(1)}}{\omega\epsilon_1} [B_1 \exp(i\beta z) + B_2 \exp(-i\beta z)]$, где β — по-

перечное волновое число, для которого $\beta^2 + (k_x^{(1)})^2 = k_0^2 \epsilon_1$, $k_0 = \omega/c = 2\pi/\lambda$ — волновое число в вакууме, λ — длина волны падающего излучения.

Два волновых числа β и k_x определяются из одного уравнения. Это означает, что одно из них можно принять независимым. Пусть это будет β . Очевидно, что набор функций (4) будет полным, если мы переберем все возможные β . Видно, что в средах 1 и 3 будет по две гармоники (такое излучение будем называть вырожденным и для определенности обозначим их "+" и "-" гармониками) и соответственно две неопределенные константы для одного значения k_x . Поэтому определение связи

между двумя свободными коэффициентами остается произвольным. Этот произвол устраняется наложением на собственные моды условий ортогональности и нормировки:

$$\int_{-\infty}^{\infty} E_{1z}^{\beta\pm} H_{1z}^{\beta\text{mi}} dz = 0 \text{ и } \int_{-\infty}^{\infty} E_{1z}^{\beta\pm} H_{1y}^{\beta\pm} dz = -\frac{c}{\omega} k_x^{(1)} \delta(\beta - \beta'). \quad (3)$$

Найдем коэффициенты B_1 и B_2 . Подставив в условие нормировки значения электрического и магнитного полей, получим: $B_1 = B_2^* = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_1}{2\pi}} (1 \pm i)$. Таким образом, в среде 1 магнитное поле будет

$$H_{1y}^{\beta\pm}(z) = \frac{1}{2} B_{1\beta} [(1 \text{ mi}) \exp(-i\beta z) + (1 \pm i) \exp(i\beta z)] \text{ где } B_{1\beta} = (\epsilon_1/2\pi)^{1/2} \text{ — нормировочная постоянная.}$$

Учитывая вышеизложенное, записываем падающее и отраженное излучение в виде

$$\mathcal{H}_{1y}^i(x, z) = \int_0^{\infty} [I_{\beta}^+ H_{1y}^{\beta+} + I_{\beta}^- H_{1y}^{\beta-}] \exp(ik_x^{(1)} x) d\beta \quad (4.1)$$

$$\mathcal{H}_{1y}^r(x, z) = \int_0^{\infty} [R_{\beta}^+ H_{1y}^{\beta+} + R_{\beta}^- H_{1y}^{\beta-}] \exp(-ik_x^{(1)} x) d\beta \quad (4.2)$$

где I_{β}^{\pm} и R_{β}^{\pm} — амплитуды падающей и отраженной волн. Падающее излучение можно определить из предпоследнего уравнения. Для этого представим магнитное поле как $\mathcal{H}(x, z) = G(z) \exp(-ik_x x)$, где $G(z) = C_0 / (1 + z^2/W_0^2)$, а C_0 и W_0 — параметры пучка. С учетом вышесказанного умножим (4.1) сначала

на $E_{1z}^{\beta+}(z)$, затем на $E_{1z}^{\beta-}(z)$ и по очереди проинтегрируем по z . Принимая во внимание условия ортогональности и нормировки (3), получаем: $\int_{-\infty}^{\infty} G(z) E_{1z}^{\beta\pm} dz = -\frac{c}{\omega} k_x^{(1)} I_{\beta}^{\pm}$.

Полученные результаты должны удовлетворять закону сохранения энергии [5]: $P^i = P^R + P^T + P^{\text{sp}}$, где P^i — падающее излучение, P^R — отраженное объемное излучение, P^T — прошедшее излучение и P^{sp} — поток поверхностного поляритона. То есть должно выполняться равенство:

$$\int_0^{\infty} (2I_{\beta} I_{\beta}^* - R_{\beta}^+ R_{\beta}^{+*} - R_{\beta}^- R_{\beta}^{-*}) k_x^{(1)} d\beta = TT^* k_s + \int_0^{\infty} T_{\beta} T_{\beta}^* k_x^{(2)} d\beta,$$

которое в совокупности с законом Френеля [6] является критерием истинности полученных результатов. Для удобства целесообразно нормировать полученные величины таким образом, чтобы падающий поток был равен единице, а вектор Пойнтинга был безразмерной величиной [7]. Для этого введем новые «нормированные» параметры гауссова пучка: $C_n = C_0/G$, $W_n = (2\pi/\lambda)W_0$, $k_x^i = k_x/k_0$, G — некоторая размерная функция. Тогда для падающего потока

$$P_x^i = \frac{c^2}{4\pi\omega} \int_0^{\infty} I_{\beta} I_{\beta}^* k_x^{(1)} d\beta = \frac{c}{8\pi} \frac{1}{\sqrt{\epsilon_1}} C_0^2 W_0 \frac{\pi}{2} = \left[\frac{cG^2 \lambda}{16\pi^2} \right] \left[\frac{\pi C_n^2 W_n}{2\sqrt{\epsilon_1}} \right]. \text{ В квадратных скобках — размерная величина, в}$$

круглых — нет. Первый множитель будет одинаков у всех потоков, поэтому на него можно сократить.

Тогда нормированный падающий поток будет равен $P_{x, \text{norm}}^i = \frac{\pi C_n^2 W_n}{2\sqrt{\epsilon_1}} = 1$ при $C_n = \sqrt{\frac{2\sqrt{\epsilon_1}}{\pi W_n}}$.

Рассмотренные в статье процессы дифракции электромагнитного излучения в пассивной волноведущей среде относятся к той ситуации, когда нелинейные добавки к диэлектрической проницаемости малы настолько, что процессы дифракции практически не зависят от интенсивности полей и их расчет основывается на линейной модели.

Литература

1. Маркузе Д. Оптические волноводы: пер. с англ. / под ред. В.В. Шевченко - М.: Мир, 1974.
2. Нефедов Е.И. Дифракция электромагнитных волн на диэлектрических структурах.- М.: Наука, 1978.
3. Петров Д.В. // Квантовая электроника. 1(2), 329, 1974.
4. Шевченко В.В. Плавные переходы в открытых волноводах. -М.: Наука, 1978.
5. Агранович В.М., Кравцов В.Е., Лескова Т.А.. // ЖЭТФ, 81(11). – С. 1828. 1981.
6. Voronko A.I., Klimova L.G., Shkerdin G.N. // Solid State Comm., 6. P. 361, 1987.
7. Поверхностные поляритоны / под ред. В.М. Аграновича, Д. Миллса - М.: Наука, 1986.
8. Дюбуа А.Б., Зилова М.А., Кучерявый С.И., Сафошкин А.С. – Кинетические процессы в умеренно легированном гетеропереходе. – Вестник РГРТУ. – 2013. – №3(45). – С. 88-92.